

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻՄՊԵՔՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Pulsed Laser Deposition system with laser system	Pulsed Laser Deposition system with laser system-	Pulsed Laser Deposition system with laser system	ZHENGZHOU CY SCIENTIFIC INSTRUMENT CO.,LTD	Հիմնական վակուումային համակարգ՝ չափս՝ Ø 300-450 մմ Նմուշի ներմուծման համակարգ՝ Ուղղահայաց գլանաձև կառուցվածք, չափս՝ Ø 120×120-160×160 մմ Վակուումային համակարգի կոնֆիգուրացիա Հիմնական վակուումային խցիկ՝ Մեխանիկական պոմպ, մոլեկուլային պոմպ, փական Նմուշի ներմուծման համակարգ՝ Մեխանիկական պոմպ և մոլեկուլային պոմպ (առաջնային խցիկի հետ համատեղ), փական Առավելագույն ճնշում Հիմնական վակուումային համակարգ՝

$$\leq 1 \cdot 10^{-6} \text{ Պա}$$

(նախապատրաստումից և գազագերծումից հետո) Նմուշի ներմուծման համակարգ՝ $\leq 1 \cdot 10^{-3}$ Պա (նախապատրաստումից և գազագերծումից հետո) Վակուումի վերականգնման համակարգ Հիմնական վակուումային համակարգ՝ Այն կարող է հասնել $(5-1) \times 10^{-3}$ Պա-ի 10-20 րոպեում (համակարգը կարճ ժամանակով ենթարկվում է մթնոլորտի ազդեցությանը և լցվում է չոր ազոտով, որպեսզի սկսվի վակուումի վերականգնումը) Նմուշի ներմուծման համակարգ՝ Այն կարող է հասնել 5×10^{-3} Պա-ի 20 րոպեում (համակարգը կարճ ժամանակով ենթարկվում է մթնոլորտի ազդեցությանը և լցվում է չոր ազոտով, որպեսզի սկսվի վակուումի վերականգնումը) Թիրախի պտտվող հարթակ՝ Թիրախի առավելագույն չափը մոտ 60 մմ է: Կարելի է միաժամանակ տեղադրվել չորս թիրախային նյութեր, թիրախը կարելի է փոփոխել պտույտի միջոցով, յուրաքանչյուր թիրախ կարող է ինքնուրույն պտտվել,

պտտման արագությունը՝ 5-60 պտ/րոպ. Ենթաշերտի տաքացում Նմուշի չափը՝ Ø40-60 Շարժման ռեժիմ՝ Ենթաշերտը անընդհատ պտտվում է, պտտման արագությունը՝ 5-70 պտ/րոպ. Ջեռուցման ջերմաստիճանը՝ Ենթաշերտի տաքացման առավելագույն ջերմաստիճանը՝ $900^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ (վերահսկվող և կարգավորելի) Գազի շրջապտույտի համակարգ՝ 1-ցիկլի գազի հոսքի կարգավորիչ, 1- ցիկլի փչող փական Լրացուցիչ պարագաներ Լազերային սարք՝ Համատեղելի է կոհերենտ լազերների հետ Լազերային ճառագայթների սկանավորման սարք՝ 2D սկանավորման մեխանիկական հարթակ, կատրոմ է ազատության երկու աստիճանի սկանավորում: Համակարգչային կառավարման համակարգ՝ Վերահսկողությունը իր մեջ ներառում է թիրախի ընդհանուր փոփոխություն, թիրախի ռոտացիա, նմուշի ռոտացիա, նմուշի ջերմաստիճանի կառավարում, լազերային ճառագայթով սկանավորում և այլն: Չբաղեցրած

տարածք չիմնական միավոր՝ 1600 *
 1600-1900 * 1900 մմ²
 Էլեկտրական խցիկ՝ 600 * 600-800
 * 800 մմ² (մեկ) չիմնական
 լազերային համակարգ՝ AO-
 S-1064-532 Լազեր Ալիքային
 ազդանշանի ալիքի երկարություն
 (նմ)՝ 532-1064 ± 1 Աշխատանքային
 ռեժիմ՝ Acousto-optics Q - անջատելի
 Մեկ իմպուլսի էներգիա (մՅ)՝ 1-350
 (350 մՋ 1 կՀց-ում; 180 մՋ 10 կՀց-
 ում) Կրկնման տեմպի
 հաճախություն (ՄՀց)՝ 0,1-100
 Իմպուլսի տևողություն՝ Սովորաբար
 7-11 նվրկ < 10 կՀց
 հաճախությունների դեպքում,
 կախված է հզորությունից և
 կրկնելիությունից Միջին հզորություն
 (մՎտ)՝ Միջին հզորությունը (մՎտ) =
 մեկ իմպուլսի էներգիա (մՅ)*
 կրկնելիության հաճախություն (ՄՀց)
 Էլեկտրաէներգիայի կայունություն (4
 ժամ RMS)՝ < 3 %, < 5 %, < 10 %,

Լայնակի ռեժիմ՝ TEM₀₀ M2
 գործակից՝ < 1,5 Ճառագայթի
 տրամագիծը բացվածքում (1/e², մմ)՝
 -1,3 (ընտրովի); -0,4 Ճառագայթների
 շեղում, ամբողջ անկյուն (mrad)՝ <
 1,5 (ընտրովի); < 5,0 Բևեռացման

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԻՄՊԵՐՍ ԳՐՈՒՄ	ԻՄՊԵՐՍ ԳՐՈՒՄ	ԻՄՊԵՐՍ ԳՐՈՒՄ	ԻՄՊԵՐՍ ԳՐՈՒՄ	ԻՄՊԵՐՍ ԳՐՈՒՄ	գործակից՝ >100 : 1 Հորիզոնական ± 5 աստիճան Տաքացման ժամանակ (րոպե)՝ < 10 Ճառագայթի բարձրությունը տակդիրից (մմ)՝ 15-20 Աշխատանքային ջերմաստիճան (օC)՝ 10-35 Սնման աղբյուր (90-264 Վտ փոփոխական հոսանք)՝ PSU - AOM - DL Ակնկալվող աշխատանքային կոդը՝ 0000-50000 Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի * «Գնումների մասին» ՀՀ տեխնիկական համակարգի օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջների համաձայն Հիմնական վակուումային զանկացած հոմակ ցեպրոսի համակարգ՝ չափս՝ Ø 300-450 մմ կիրառելի են «կամ համալուծել» Նմուշի ներմուծման համակարգ բառերը: Ուղղահայաց գլանաձև կառուցվածք, չափս՝ Ø 120x120-160x160 մմ Վակուումային համակարգի կոնֆիգուրացիա Հիմնական վակուումային խցիկ՝ Մեխանիկական պոմպ, մոլեկուլային պոմպ, փական Նմուշի ներմուծման համակարգ՝ Մեխանիկական պոմպ և մոլեկուլային պոմպ (առաջնային խցիկի հետ համատեղ), փական Առավելագույն ճնշում Հիմնական վակուումային համակարգ՝
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	Предлагаемый товар	0000-50000 Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի * «Գնումների մասին» ՀՀ տեխնիկական համակարգի օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջների համաձայն Հիմնական վակուումային զանկացած հոմակ ցեպրոսի համակարգ՝ չափս՝ Ø 300-450 մմ կիրառելի են «կամ համալուծել» Նմուշի ներմուծման համակարգ բառերը: Ուղղահայաց գլանաձև կառուցվածք, չափս՝ Ø 120x120-160x160 մմ Վակուումային համակարգի կոնֆիգուրացիա Հիմնական վակուումային խցիկ՝ Մեխանիկական պոմպ, մոլեկուլային պոմպ, փական Նմուշի ներմուծման համակարգ՝ Մեխանիկական պոմպ և մոլեկուլային պոմպ (առաջնային խցիկի հետ համատեղ), փական Առավելագույն ճնշում Հիմնական վակուումային համակարգ՝
1	Pulsed Laser Deposition system with laser system	Pulsed Laser Deposition system with laser system	Pulsed Laser Deposition system with laser system	ZHENGZHOU CY SCIENTIFIC INSTRUMENT CO.,LTD	0000-50000 Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի * «Գնումների մասին» ՀՀ տեխնիկական համակարգի օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջների համաձայն Հիմնական վակուումային զանկացած հոմակ ցեպրոսի համակարգ՝ չափս՝ Ø 300-450 մմ կիրառելի են «կամ համալուծել» Նմուշի ներմուծման համակարգ բառերը: Ուղղահայաց գլանաձև կառուցվածք, չափս՝ Ø 120x120-160x160 մմ Վակուումային համակարգի կոնֆիգուրացիա Հիմնական վակուումային խցիկ՝ Մեխանիկական պոմպ, մոլեկուլային պոմպ, փական Նմուշի ներմուծման համակարգ՝ Մեխանիկական պոմպ և մոլեկուլային պոմպ (առաջնային խցիկի հետ համատեղ), փական Առավելագույն ճնշում Հիմնական վակուումային համակարգ՝
					կառուցվածք, չափս՝ Ø 120x120-160x160 մմ Վակուումային համակարգի կոնֆիգուրացիա Հիմնական վակուումային խցիկ՝ Մեխանիկական պոմպ, մոլեկուլային պոմպ, փական Նմուշի ներմուծման համակարգ՝ Մեխանիկական պոմպ և մոլեկուլային պոմպ (առաջնային խցիկի հետ համատեղ), փական Առավելագույն ճնշում Հիմնական վակուումային համակարգ՝

$$\leq 1 \cdot 10^{-6} \text{ Պա}$$

(նախապատրաստումից և գազագերծումից հետո) Նմուշի ներմուծման համակարգ՝ $\leq 1 \cdot 10^{-3}$ Պա (նախապատրաստումից և գազագերծումից հետո) Վակուումի վերականգնման համակարգ Հիմնական վակուումային համակարգ՝ Այն կարող է հասնել $(5-1) \times 10^{-3}$ Պա-ի 10-20 րոպեում (համակարգը կարճ ժամանակով ենթարկվում է մթնոլորտի ազդեցությանը և լցվում է չոր ազոտով, որպեսզի սկսվի վակուումի վերականգնումը) Նմուշի ներմուծման համակարգ՝ Այն կարող է հասնել 5×10^{-3} Պա-ի 20 րոպեում (համակարգը կարճ ժամանակով ենթարկվում է մթնոլորտի ազդեցությանը և լցվում է չոր ազոտով, որպեսզի սկսվի վակուումի վերականգնումը) Թիրախի պտտվող հարթակ՝ Թիրախի առավելագույն չափը մոտ 60 մմ է: Կարելի է միաժամանակ տեղադրվել չորս թիրախային նյութեր, թիրախը կարելի է փոփոխել պտույտի միջոցով, յուրաքանչյուր թիրախ կարող է ինքնուրույն պտտվել,

պտտման արագությունը՝ 5-60 պտ/րոպ. Ենթաշերտի տաքացում Նմուշի չափը՝ Ø40-60 Շարժման ռեժիմ՝ Ենթաշերտը անընդհատ պտտվում է, պտտման արագությունը՝ 5-70 պտ/րոպ. Ջեռուցման ջերմաստիճանը՝ Ենթաշերտի տաքացման առավելագույն ջերմաստիճանը՝ $900^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ (վերահսկվող և կարգավորելի) Գազի շրջապտույտի համակարգ՝ 1-ցիկլի գազի հոսքի կարգավորիչ, 1- ցիկլի փչող փական Լրացուցիչ պարագաներ Լազերային սարք՝ Համատեղելի է կոհերենտ լազերների հետ Լազերային ճառագայթների սկանավորման սարք՝ 2D սկանավորման մեխանիկական հարթակ, կատրում է ազատության երկու աստիճանի սկանավորում: Համակարգչային կառավարման համակարգ՝ Վերահսկողությունը իր մեջ ներառում է թիրախի ընդհանուր փոփոխություն, թիրախի ռոտացիա, նմուշի ռոտացիա, նմուշի ջերմաստիճանի կառավարում, լազերային ճառագայթով սկանավորում և այլն: Չբաղեցրած

տարածք չիմնական միավոր՝ 1600 *
 1600-1900 * 1900 մմ²
 Էլեկտրական խցիկ՝ 600 * 600-800
 * 800 մմ² (մեկ) չիմնական
 լազերային համակարգ՝ AO-
 S-1064-532 Լազեր Ալիքային
 ազդանշանի ալիքի երկարություն
 (նմ)՝ 532-1064 ± 1 Աշխատանքային
 ռեժիմ՝ Acousto-optics Q - անջատելի
 Մեկ իմպուլսի էներգիա (մՅ)՝ 1-350
 (350 մՋ 1 կՀց-ում; 180 մՋ 10 կՀց-
 ում) Կրկնման տեմպի
 հաճախություն (ՄՀց)՝ 0,1-100
 Իմպուլսի տևողություն՝ Սովորաբար
 7-11 նվրկ < 10 կՀց
 հաճախությունների դեպքում,
 կախված է հզորությունից և
 կրկնելիությունից Միջին հզորություն
 (մՎտ)՝ Միջին հզորությունը (մՎտ) =
 մեկ իմպուլսի էներգիա (մՅ)*
 կրկնելիության հաճախություն (ՄՀց)
 Էլեկտրաէներգիայի կայունություն (4
 ժամ RMS)՝ < 3 %, < 5 %, < 10 %,

Լայնակի ռեժիմ՝ TEM₀₀ M2
 գործակից՝ < 1,5 Ճառագայթի
 տրամագիծը բացվածքում (1/e², մմ)՝
 -1,3 (ընտրովի); -0,4 Ճառագայթների
 շեղում, ամբողջ անկյուն (mrad)՝ <
 1,5 (ընտրովի); < 5,0 Բևեռացման

				<p>գործակից՝ $>100 : 1$ Հորիզոնական ± 5 աստիճան Տաքացման ժամանակ (րոպե)՝ < 10 Ճառագայթի բարձրությունը տակդիրից (մմ)՝ 15-20 Աշխատանքային ջերմաստիճան (օC)՝ 10-35 Սնման աղբյուր (90-264 Վտ փոփոխական հոսանք)՝ PSU - AOM - DL Ակնկալվող աշխատանքային ժամանակահատված (ժամ)՝ 1 0000-50000 Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի * «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջների համաձայն ցանկացած հղման դեպքում կիրառելի են «կամ համարժեք» բառերը:</p>
--	--	--	--	--